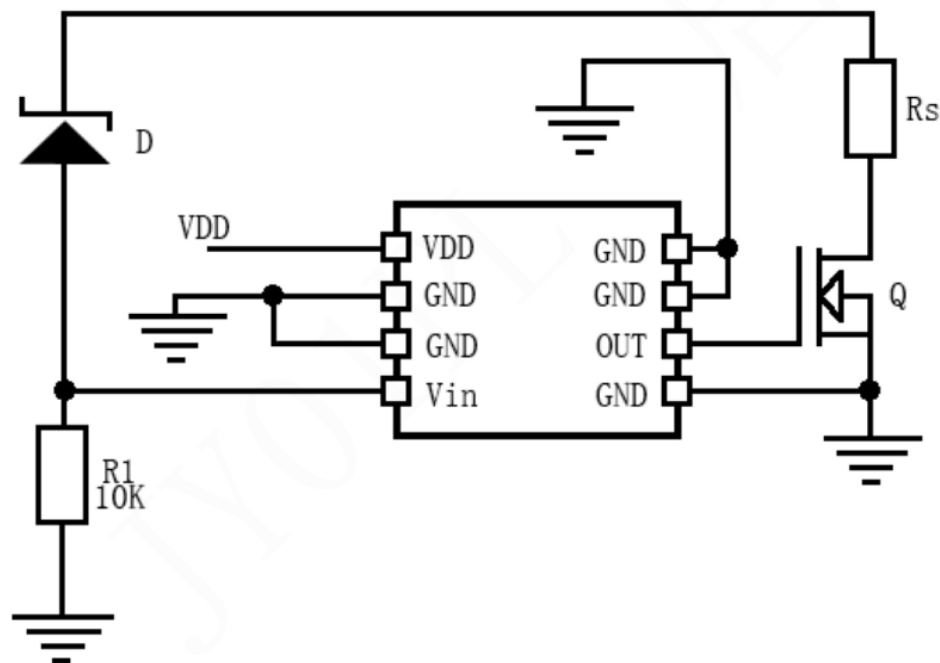


JY01PL 为一款专门为电机驱动电路配套使用的能量释放管理芯片，主要功能是检测电源电压高于设定值时直接驱动 MOS 管将多余电能释放掉，保护电机驱动电路及周边设备不被电机刹车时产生的高电压损坏。

特性

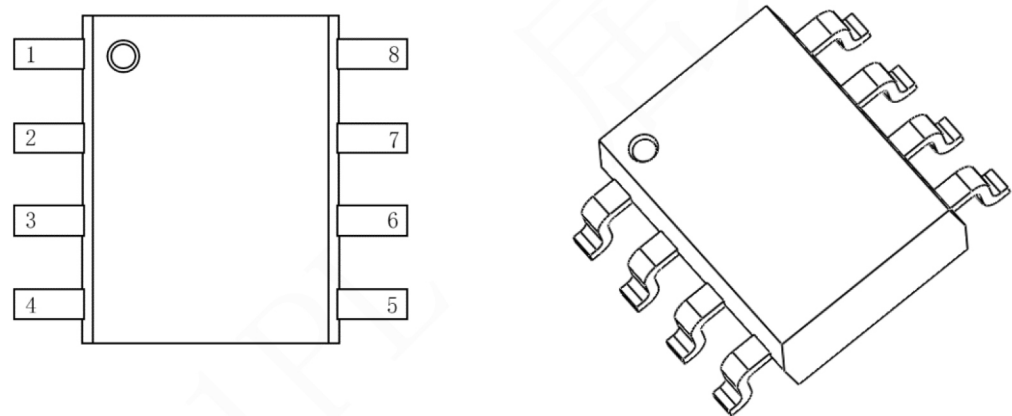
- ## 应用

- ### 典型应用图



能量释放管理芯片

封装和引脚功能



SOP-8

引脚名称	引脚序号	引脚功能描述
VDD	1	电压输入端
GND	2, 3, 5, 7, 8	地
Vin	4	过压信号输入端 释放值 2.2V/恢复值 1.8V
OUT	6	输出端 当 Vin 电压大于 2.2V 时此脚输出高电平, 当 Vin 电压低于 1.8V 时恢复至低电平

说明：4 脚 (Vin) 电压低于基准电压以下比较器输出低电平，OUT 输出也为低电平，功率管 Q 关断，一但电压高于内部基准电压，比较器输出高电平，同时 OUT 输出为高电平，功率管 Q 导通，电源通过 Rs 负载电阻直到电源负极，及时将电机发出的电能释放掉，起到保护电路及外围设备的目的

芯片内部框图可以看到比较器上的两只电阻，它反馈比例约 10%左右，起到一定的迟滞作用，所以比较器的实际翻转电压约为 2. 2V，反回电压约 1. 8V。我们只要掌握 JY01PL 这些特征使用起来更灵活

- 能量释放功率 MOS 管 Q 与能量释放电阻 Rs 选型问题
- 1、功率管 Q 选型：正常与你电机驱动用 MOS 管参数一样就可以
 - 2、能量释放电阻 Rs 选型：Rs 上流过的电流≤MOS 管额定电流，电阻值不能为 0
 - 3、能量释放电阻功率大小要根据实际应用，按最大的刹车频率测试，通过测试后得出合适功率值，一般功率选大不选小

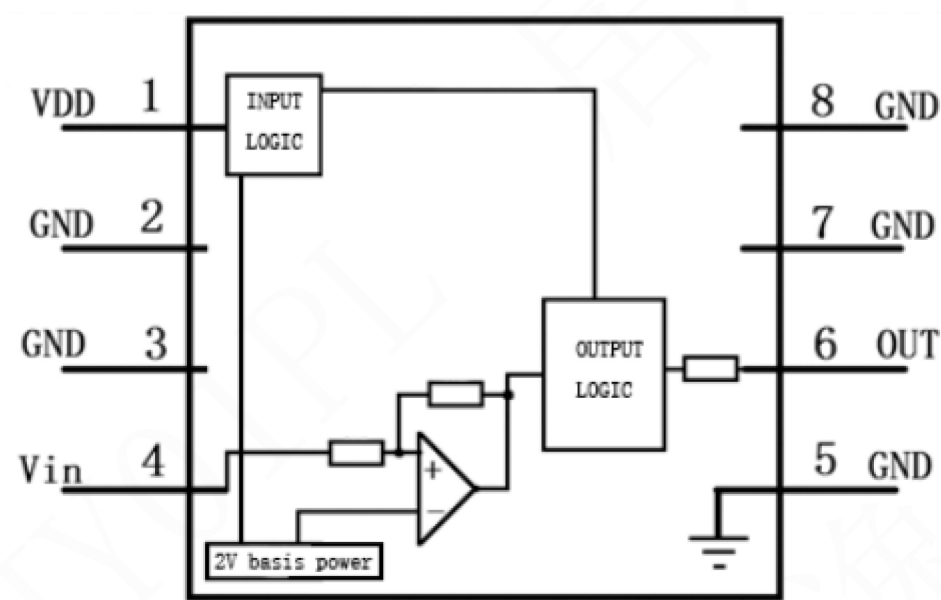
绝对最大额定值

描述	极限值	单位
输入电压范围 VDD	8-15	V
输出电流范围 OUT	<280	mA
工作温度范围	-40~125	℃
储存温度范围	-55~150	℃

注： 各项参数若超出“绝对最大值” 的范围， 将有可能对芯片造成永久性损伤。 以上给出的仅是极限范围，在这样的极限条件下工作， 芯片的技术指标将得不到保证。
长期工作在“绝对最大值” 附近， 会影响到芯片的可靠性。

能量释放管理芯片

芯片内部框图



封装尺寸图

